

PENENTUAN KEHALUSAN LAPISAN TIPIS $\text{Ni}_{80}\text{Fe}_{20}$ MELALUI NILAI KAPASITANSI LAPISAN PADA UNTAI TAPIS R-C LOLOS RENDAH

Moh. Toifur¹ Venty Aghnani Nurhamidy¹ dan Sujatmoko²

¹FMIPA Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Jl. Prof. Dr. Soepomo Janturan Yogyakarta 55164

²Puslitbang Teknologi Maju (P3TM) - BATAN

Babarsari, Kotak Pos : 1008, DI Yogyakarta 55010

ABSTRAK

PENENTUAN KEHALUSAN LAPISAN TIPIS $\text{Ni}_{80}\text{Fe}_{20}$ MELALUI NILAI KAPASITANSI LAPISAN PADA UNTAI TAPIS R-C LOLOS RENDAH. Telah dilakukan penelitian tentang watak kapasitif lapisan tipis $\text{Ni}_{80}\text{Fe}_{20}$ hasil deposisi dengan teknik *sputtering* pada variasi medan deposisi dari 0 G sampai dengan 600 G. Penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat kehalusan lapisan dengan menentukan nilai kapasitor dalam lapisan jika porositas dalam lapisan diperlakukan sebagai kapasitor, serta unjuk kerja lapisan sebagai tapis lolos rendah. Rangkaian terdiri dari tahanan $R = 769,9 \Omega$ yang dihubungkan secara seri dengan lapisan dan dipasok tegangan AC dari AFG. Pengamatan watak kapasitif dilakukan pada frekuensi 100 kHz sedangkan pengamatan frekuensi potong dilakukan pada frekuensi 100 kHz sampai dengan 1000 kHz. Tegangan output dan input diamati melalui osiloskop. Dari karakterisasi watak kapasitif menunjukkan bahwa semua lapisan menunjukkan watak kapasitif. Sampel hasil deposisi pada $B_{dep} = 300 \text{ G}$ memiliki kapasitansi terkecil yaitu 0,09 pF, hal mana menunjukkan lapisan yang paling halus dibanding lapisan yang lain. Lapisan ini dapat menapis frekuensi hingga 253,5 Hz.

Kata kunci : Kapasitif, tapis lolos rendah, frekuensi potong

ABSTRACT

DETERMINATION OF THE $\text{Ni}_{80}\text{Fe}_{20}$ THIN FILM SMOOTHNESS THROUGH THE CAPASITANCE OF FILM IN THE LOW PASS R-C FILTER DEVICE. Capacitive properties of $\text{Ni}_{80}\text{Fe}_{20}$ thin film as the result of dc sputtering on the various deposition field (B_{dep}) from 0 up to 600 G was reached. The aim of the research is to determine the smoothness of film with investigating the capacitance due to film porosities, and the performance of film as low pass filter. Device constitute of the resistor $R = 769.9 \Omega$ serially connected with a film. Device was supplied with AC voltage from AFG. Investigating the capacitive properties was done on the 100 kHz frequency, while investigating the cut-off frequency was done in the range of 100 up to 1000 kHz. The output and input voltage were investigated through oscilloscope. From investigating the capacitive properties show that all samples display capacitive properties. The lowest capacitance according to the sample resulted from deposition on the B_{dep} of 300 G that is 0.09 pF, which is show the smoothest film compared with others. It is can filter the frequencies up to 253.5 Hz.

Key words : Capacitive, low pass filter, cutt-of frequency

PENDAHULUAN

Salah satu parameter yang menunjukkan kehalusan lapisan tipis yang dihasilkan pada proses deposisi adalah homogenitas lapisan. Pada lapisan yang halus tidak ditemukan atau hanya sedikit ditemukan porositas karena atom-atom tersebar merata pada setiap lokasi pada permukaan substrat. Sebaliknya pada lapisan yang kurang halus, banyak mengandung porositas. Porositas dapat dipandang sebagai rongga-rongga kecil yang berukuran mikron atau lebih kecil lagi. Jika lapisan berasal dari bahan konduktor (logam baik magnetik maupun non magnetik) maka kehadiran porositas (rongga) ini dapat mengganggu proses hantaran arus

listrik sehingga konduktivitas lapisan menyimpang dari konduktivitas normalnya. Untuk lapisan yang sangat tipis maka kehadiran porositas ini dapat tembus pandang sehingga dapat diamati menggunakan alat seperti mikroskop optik.

Jika pada lapisan yang mengandung porositas pada kedua sisinya dicatu dengan sumber tegangan, baik DC maupun AC, maka sisi rongga yang berdekatan dengan kutub positif memiliki potensial yang lebih positif dari sisi rongga yang berdekatan dengan kutub negatif. Akibatnya arus listrik akan mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Jika arus listrik dalam

perjalanannya menumbuk rongga maka sebagian arus akan mencari jalur lain di luar rongga dan sebagian menempati sisi rongga sebagai muatan permukaan (dengan rapat muatan σ) pada kedua sisi rongga. Akibatnya rongga ini dapat berfungsi sebagai kapasitor (penampung muatan listrik) dan medium di dalam rongga berperan sebagai dielektrikum. Lapisan yang memiliki jumlah rongga banyak dan berukuran rongga besar memiliki kapasitansi (C) yang besar sementara pada lapisan yang memiliki jumlah rongga sedikit dan berukuran kecil akan memiliki kapasitansi yang kecil.

Pada makalah ini akan dibahas penentuan nilai kapasitansi lapisan tipis *permalloy* (Ni₈₀Fe₂₀) hasil deposisi dengan teknik *sputtering* DC pada variasi medan deposisi. Pendugaan lapisan memiliki watak kapasitif diuji dengan menggunakan rangkaian *filter RC* lolos rendah yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC bentuk sinus dari AFG (Audio Frequency Generator) dengan frekuensi yang dapat diatur.

Tegangan output ditampilkan secara visual melalui layar CRO. Jika tegangan output dari lapisan berbentuk gelombang segitiga maka lapisan bersifat kapasitif. Selanjutnya nilai C dapat ditentukan dengan dua cara yaitu dari nilai konstanta fitting B yang nilainya sama dengan $1/RC$ jika data (t_i, V_i) difitting mengikuti persamaan

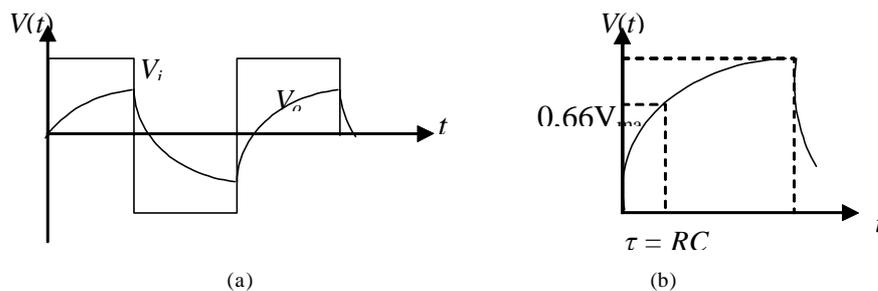
$$y = Ae^{-Bx}$$

dengan $x = t$ dan $y = V$. Yang kedua dari konstanta waktu $\tau = RC$ yang bersesuaian dengan tegangan $V = 0,66 V_{\max}$ pada kurva V vs t .

TEORI

Watak Kapasitif Lapisan

Jika pada kapasitor dialiri arus listrik gelombang kotak maka respon arus pada kapasitor tidak lagi berupa gelombang kotak tetapi ada reduksi sehingga menjadi gelombang segitiga (tidak sempurna). Reduksi ini terjadi karena adanya pengisian dan pengosongan kapasitor. Bentuk kurva masukan dan keluaran seperti ditunjukkan pada Gambar 1. Jika V_{\max} adalah tegangan



Gambar 1. (a) Respon tegangan kapasitor (V_o) terhadap tegangan masukan gelombang kotak (V_i). (b) Grafik V vs t serta posisi $\tau = RC$ yang bersesuaian dengan $V = 0,66 V_{\max}$

input yang diukur dari puncak ke puncak (V_{pp}) maka persamaan untuk tegangan keluaran pada kapasitor adalah:

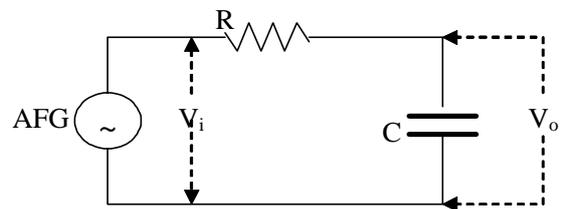
$$V_o(t) = V_{\max} (1 - e^{-t/RC}) \dots\dots\dots (1)$$

dengan $t =$ waktu, $R =$ resistansi, $C =$ kapasitansi, $V_{\max} =$ tegangan maksimum. Pada $t = RC$ atau biasa disebut dengan tetapan waktu (*time constant*, τ), maka persamaan (1) menjadi:

$$V_o(t) = 0,66V_{\max} \dots\dots\dots (2)$$

Rangkaian filter RC Lolos Rendah

Rangkaian *filter RC* lolos rendah merupakan rangkaian elektronik yang dapat meloloskan frekuensi sampai batas tertentu dan mengemblok frekuensi di atasnya (Holko, 2005). Rangkaian *filter RC* lolos rendah terdiri dari R dan C yang terusun seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan AC berbentuk kotak. Rangkaian ini akan menjadi rangkaian tapis lolos rendah (LPF, *low pass filter*) jika dioperasikan pada kawasan frekuensi yang bertujuan untuk meloloskan sinyal tegangan V_i pada frekuensi rendah. Gambar 2 menunjukkan rangkaian *filter RC* lolos rendah ini [1,2]



Gambar 2. Rangkaian *filter RC* lolos rendah

Mengingat besarnya reaktansi kapasitif pada kapasitor adalah [3]:

$$X_C = \frac{1}{\omega C} \dots\dots\dots (3)$$

maka pada frekuensi ω sangat rendah, reaktansi kapasitif dari kapasitor sangat tinggi, atau dengan kata lain kapasitor bersifat terbuka sehingga V_i dapat

lolos dengan leluasa. Penguatan yang dialami oleh V_i dikenal dengan *gain* atau fungsi alih $G(\omega)$ yang didefinisikan dengan:

$$G(\omega) = \frac{V_o}{V_i} \dots\dots\dots (4)$$

Jika dinyatakan dalam desibel menjadi:

$$G(\omega)(dB) = 20 \log \frac{V_o}{V_i} \dots\dots\dots (5)$$

Kurva fungsi alih $G(\omega)$ vs ω jika diplot dalam skala logaritma disebut dengan kurva tanggap amplitudo [4]. Batas frekuensi V_i yang dikuatkan disebut frekuensi potong (f_p) yaitu frekuensi dimana nilai $G(\omega) = -3$ dB.

Pada prakteknya komponen C pada Gambar 2 dapat digantikan lapisan tipis dimana lapisan ini mengandung resistor (R_L) dan kapasitor. Oleh karena itu tahanan total dalam rangkaian terdiri dari R_0 dan R_L sehingga R totalnya adalah jumlah dari keduanya.

$$R = R_0 + R_L \dots\dots\dots (6)$$

dengan R_0 = tahanan beban diluar lapisan dan R_L = tahanan pada lapisan. Tahanan lapisan (R_L) dapat berasal dari struktur kristal atom-atom pada lapisan yang tidak sempurna, getaran atom lapisan karena suhu serta kemungkinan adanya *impurity* pada lapisan. Selain itu pada lapisan magnetik juga terdapat R tambahan yaitu yang berasal dari interaksi elektron konduksi dari arus listrik dengan elektron valensi pada bahan magnetik jika *spin-spinnya* saling berlawanan.

Penentuan Kapasitansi Lapisan

Dari persamaan (1) dapat dilakukan *fitting* data data waktu terhadap tegangan (t_p, V_p) menurut pers.

$$y = y_0 + Ae^{-Bx} \dots\dots\dots (7)$$

dengan $x = t$ dan $y = V$. Dari *fitting* data ini diperoleh konstanta-konstanta *fitting* A dan B . Nilai $B = 1/RC$. Dengan memasukkan nilai R menurut persamaan (6) maka dapat ditentukan nilai C :

$$C = \frac{1}{B(R_0 + R_L)} \dots\dots\dots (8)$$

Cara yang lain untuk menentukan C adalah dengan menentukan nilai konstanta waktu τ yang bersesuaian dengan tegangan $0,66 V_{max}$ sebagaimana diungkapkan pada pers.amaan (2). Jika τ dan R diketahui maka:

$$C = \tau/R \dots\dots\dots (9)$$

Penentuan Pita Frekuensi Tapis Lolos Rendah

Penentuan lebar pita frekuensi yang diloloskan dapat ditentukan dengan menggambar grafik $G(\omega)$ vs ω . Frekuensi yang bersesuaian dengan $G(\omega) = -3$ dB merupakan frekuensi potong (f_p). Lebar pita frekuensi dimulai dari frekuensi terendah sampai f_p ini.

METODE PERCOBAAN

Bahan

Bahan yang diteliti adalah lapisan tipis yang digunakan pada penelitian ini adalah lapisan tipis *permalloy* hasil deposisi dengan teknik *sputtering* pada variasi medan deposisi dari 50 s/d 600 G yang dilapiskan diatas substrat gelas.

Alat

Peralatan pokok yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: AFG sebagai sumber tegangan AC menggunakan frekuensi dari 100 kHz sampai dengan 1000 kHz, mikroskop optik dengan perbesaran 40 kali untuk mengamati tampang permukaan lapisan. Sistem kerja mikroskop ini telah terkomputerisasi sehingga gambarnya dapat disimpan dalam bentuk *file*, osiloskop untuk mengamati bentuk gelombang *input* AFG dan *output* pada lapisan. Untuk mengamati tegangan input, tegangan output serta mengukur resistansi lapisan digunakan Multimaster Digital 570 merk True RMS produksi Extech Instrument. Selain itu untuk memotret isyarat keluaran dari osiloskop digunakan kamera digital merk Nixon E4300, produksi Nixon Corp. Japan, *probe* dua titik untuk memberi fasilitas catu tegangan pada lapisan, potensiometer untuk menentukan besarnya R yang sesuai dengan kebutuhan setelah dirangkai bersama-sama lapisan pada rangkaian tapis lolos rendah. Selain alat-alat tersebut juga digunakan *software* untuk *memfitting* data V_o terhadap t menurut persamaan (7) dengan menggunakan program "*Igor*".

Cara Kerja

Penelitian dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut :

- a. Tampang permukaan lapisan tipis $Ni_{80}Fe_{20}$ dipotret dengan mikroskop optik dan disimpan dengan nama *file* tertentu.
- b. Membuat rangkaian *filter* lolos rendah sebagaimana rangkaian Gambar 2 dengan memasang lapisan sebagai kapasitor dan menghubungkan dengan sumber tegangan AC dari AFG pada frekuensi 100 kHz. Pengamatan tegangan input dan output dilakukan dengan osiloskop pada mode dual (XY) agar supaya V_i dan V_o dapat terbedakan secara jelas.

- Selanjutnya tampilan pada layar CRO dipotret dengan kamera digital. Sementara itu pengukuran tahanan lapisan dilakukan dengan multimaster.
- Frekuensi pada AFG diubah pada interval 100 kHz sampai dengan 1000 kHz dan setiap kali mengubah frekuensi maka tegangan masukan (V_i) dan tegangan keluaran (V_o) diukur dengan multimaster. Dari data ini dapat diplot kurva tanggap amplitudo $G(\omega)$ terhadap ω .
 - Mengulangi prosedur a sampai dengan c untuk sampel yang lain.

Analisis Data

Pertama dibuktikan dulu adanya porositas pada lapisan. Ini dapat dilihat dari fotograf sampel yang dipotret dengan mikroskop optik. Selanjutnya dari gambar ini secara kualitatif diamati pengaruh B_{dep} terhadap jumlah porositas. Dari nilai C masing-masing sampel (yang telah dihitung menggunakan persamaan (8) dan persamaan (9) diplot grafik C vs B_{dep} . Dari grafik tersebut dianalisis pengaruh B_{dep} terhadap nilai C lapisan. Nilai-nilai C yang diperoleh dari kedua cara tersebut dibandingkan untuk mengetahui kesalahan relatif cara kedua terhadap cara pertama. Lebar frekuensi yang diloloskan ditentukan dari gambar $G(\omega)$ vs ω , f_p merupakan f pada $G(\omega) = -3$ dB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Foto Mikroskop Optik Lapisan Tipis $Ni_{80}Fe_{20}$

Pada Gambar 3 ditampilkan foto lapisan tipis $Ni_{80}Fe_{20}$ hasil deposisi dengan teknik *sputtering* pada

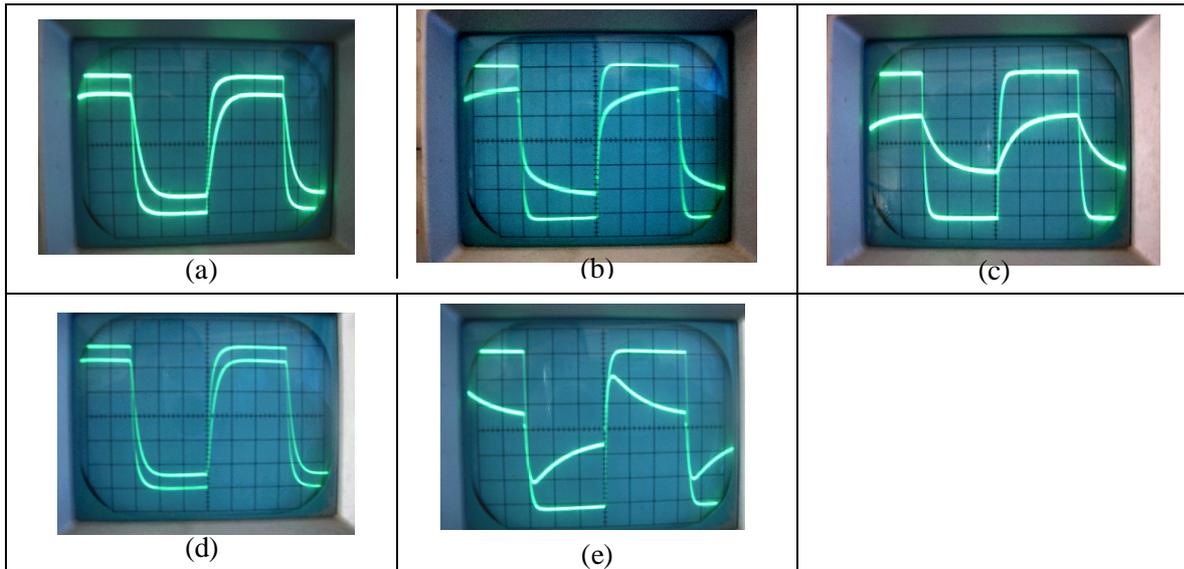
variasi medan deposisi dari 0 gauss sampai dengan 600 gauss yang diambil dengan mikroskop optik. Garis hitam di bagian bawah gambar merupakan ukuran panjang 1 mm. Dari gambar tersebut tampak bahwa semua lapisan mengandung lubang (porositas). Besar medan deposisi berpengaruh jumlah porositas.

Dari medan deposisi 0 gauss sampai dengan 300 gauss permukaan lapisan semakin halus yang ditandai dengan semakin sedikit serta semakin kecil ukuran rata-rata dari porositas. Pada medan deposisi dari 300 gauss sampai dengan 600 gauss permukaan lapisan tampak semakin kasar. Dengan demikian B_{dep} optimal untuk menghasilkan permukaan lapisan paling halus yaitu 300 gauss. Diperkirakan nilai C lapisan ini paling kecil dibanding lapisan yang lain.

Watak Kapasitif Lapisan

Pada Gambar 4 ditampilkan foto kurva V terhadap t dari masing-masing lapisan pada layar osiloskop. Gambar diambil pada frekuensi 100 KHz. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa semua lapisan menampilkan watak kapasitif yang ditandai dengan adanya perubahan bentuk isyarat masukan yang berupa gelombang kotak menjadi berbentuk gelombang segitiga tak sempurna pada isyarat keluaran. Bentuk gelombang keluaran seperti tersebut menandakan pada lapisan terjadi pengisian dan pengosongan muatan. Khusus untuk lapisan yang ke lima [Gambar 4(e)] yaitu lapisan yang dihasilkan pada medan deposisi 600 gauss, isyarat keluarannya seperti pada kapasitor jika dirangkai mengikuti rangkaian *filter RC* tapis lolos tinggi (HPF). Lapisan ini tidak diteliti lebih

Gambar 3. Foto tampak lintang lapisan tipis $Ni_{80}Fe_{20}$ hasil deposisi pada variasi medan deposisi (B_{dep}) yang diambil dengan menggunakan mikroskop optik pada perbesaran 40 x. Garis hitam merupakan ukuran panjang 1 mm



Gambar 4. Isyarat masukan dan keluaran lapisan hasil deposisi pada berbagai B_{dep} pada rangkaian filter lolos rendah dengan tegangan *input* berbentuk gelombang kotak. (a) 0 G, (b) 150 G, (c) 300 G, (d) 450 G, (e) 600 G.

Tabel 1. Persamaan *fitting set* data (t_i, V_i) lapisan hasil deposisi pada variasi B_{dep}

B_{dep} (G)	Persamaan <i>fitting</i>	R (Ω)	C dari konstanta <i>fitting</i> B (pF)	C' dari konstanta waktu τ (pF)	$\frac{\Delta C'}{C'} \times 100\%$
0	$V(t) = 4,56 - 5,078e^{-4718800t}$	4654,6	45,53	60,91	25,25
150	$V(t) = 0,82 - 0,83e^{-4821800t}$	146139,6	1,42	1,48	4,16
300	$V(t) = 4,50 - 4,50e^{-1333200t}$	7938770	0,09	0,10	8,19
450	$V(t) = 9,25 - 10,87e^{-3343000t}$	177829,6	1,78	2,49	32,47
600	$V(t) = 7,4 - 8,06e^{-4,42740t}$	1078,6	2093,99	2614,40	19,91

lanjut karena memerlukan dukungan teori selain *filter RC* lolos rendah.

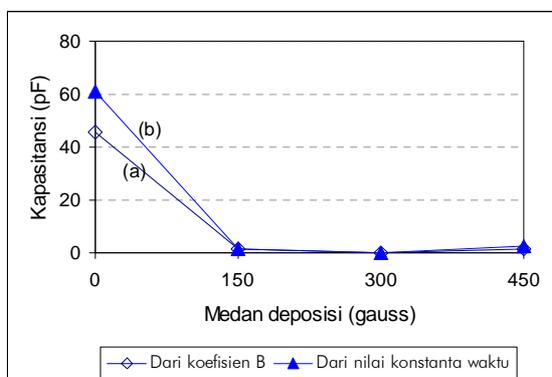
Selanjutnya dengan melihat perubahan tingkat kelengkungan V_o serta nilai V_{mak} dari masing-masing grafik tampak bahwa medan deposisi berpengaruh pada nilai C masing-masing lapisan. Pada kurva V_o yang landai maka nilai $1/RC$ besar atau nilai C kecil. Sebaliknya pada

kurva V_o yang curam maka nilai C besar. Untuk mengetahui secara kuantitatif nilai C maka pada subbagian 4 ditampilkan hasil *fitting* data V terhadap t masing-masing sampel.

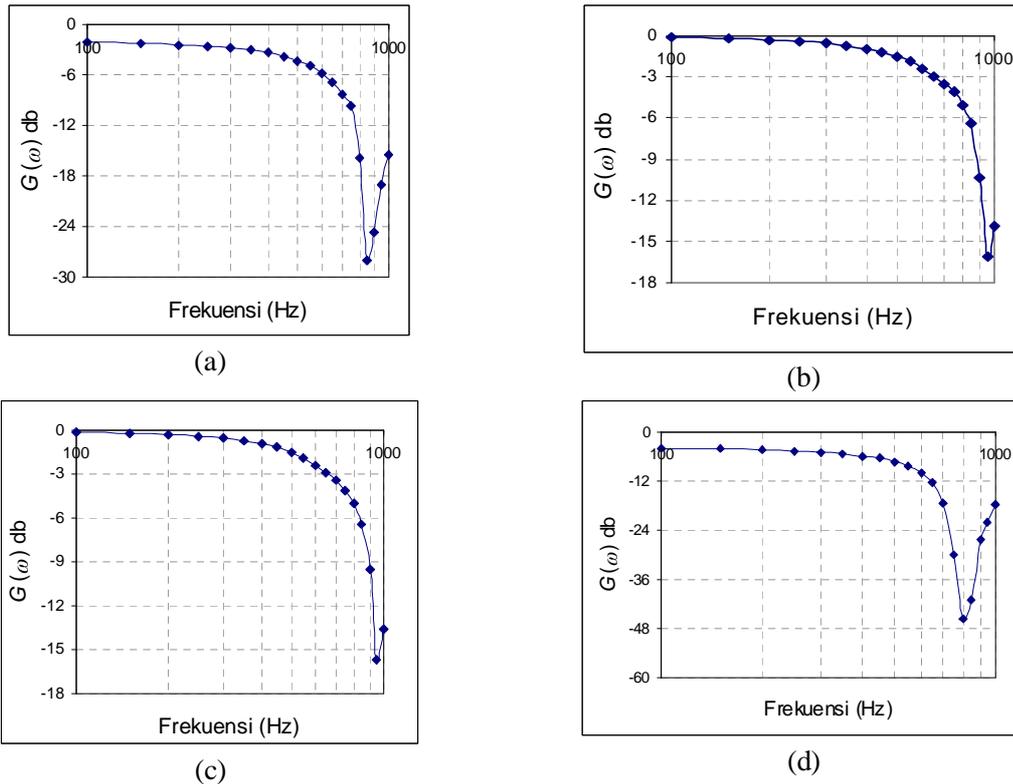
Kapasitansi Lapisan

Pada Tabel 1 ditampilkan persamaan kurva hasil *fitting* data V_i vs t_i untuk masing-masing sampel menurut persamaan (7). Dari nilai B masing-masing persamaan, melalui persamaan (8) dan persamaan (9) dengan mengambil R sebagaimana ditampilkan pada kolom 4 Tabel 1 maka diperoleh nilai C seperti pada kolom 5 dan kolom 6.

Dari kolom 5 tampak bahwa nilai kapasitansi masing-masing lapisan cukup kecil yaitu berorde 10^{-1} pF sampai dengan 10^3 pF. Grafik yang melukiskan kaitan antara kapasitansi (C) lapisan dengan medan deposisi (B_{dep}) dapat dilihat pada Gambar 5. Tampak bahwa besarnya medan deposisi berpengaruh terhadap besarnya nilai C . Dari medan deposisi 0 G sampai dengan 300 G, nilai C turun dari 45,53 pF menjadi 0,09 pF. Pada medan deposisi 300 G sampai dengan



Gambar 5. Grafik hubungan antara kapasitansi dan medan deposisi. (a) Nilai C yang dihitung dari konstantan *fitting* B , (b) Nilai C yang dihitung dari konstanta waktu τ .



Gambar 6. Fungsi alih lapisan $Ni_{80}Fe_{20}$ dalam skala logaritma dengan variasi besar medan deposisi: (a) 0 G, (b) 150 G, (c) 300 G, (d) 450 G.

450 G, nilai C naik dari $0,09 \times pF$ menjadi $2093,99 pF$. Hal ini menunjukkan bahwa medan $B_{dep} = 300 G$ merupakan medan optimum untuk menghasilkan lapisan paling halus dan paling sedikit mengandung porositas relatif terhadap lapisan yang lain. Hasil ini sesuai dengan hasil yang diperoleh pada fotograf tampak permukaan sampel di atas (sub bagian C.1).

Tanggap Amplitudo

Pada Gambar 6 ditampilkan grafik $G(\omega)$ terhadap f masing-masing sampel yang diamati pada rentang frekuensi dari 100 kHz sampai dengan 1 MHz.

Hasilnya semua lapisan menampilkan sifatnya sebagai tapis lolos rendah. Pada nilai R sebagaimana ditampilkan pada kolom 3 Tabel 1 maka frekuensi potong untuk masing-masing sampel sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2. Melihat pada ujung kurva pada Gambar 6 masih mengalami kenaikan maka ada kemungkinan lapisan bukan hanya sebagai tapis lolos

Tabel 2. Frekuensi potong lapisan tipis $Ni_{80}Fe_{20}$

No	B_{dep} (G)	Frekuensi potong f_p (Hz)
1	0	336,1
2	150	650,2
3	300	253,5
4	450	Tidak diketahui karena $G(\omega) = -3 dB$ terletak pada $freq. < 100 kHz$

rendah namun menjadi tapis tolak pita frekuensi tertentu (*band rejection filter*) yaitu jika $G(\omega)$ naik sampai melampaui $-3 dB$. Pada penelitian ini frekuensi dijalankan hingga 1 MHz disebabkan keterbatasan frekuensi osilator yang dimiliki.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Lapisan tipis $Ni_{80}Fe_{20}$ hasil deposisi pada berbagai medan deposisi memiliki sifat kapasitif. Kapasitansi terkecil bersesuaian dengan $B_{dep} = 300 G$ yaitu $0,09 pF$ hal mana menunjukkan lapisan ini paling halus dibanding lapisan yang lain.
2. Dengan memperlakukan lapisan sebagai kapasitor pada rangkaian RC maka lapisan dapat berfungsi sebagai tapis lolos rendah. Frekuensi potong untuk lapisan hasil deposisi pada $B_{dep} = 300 G$ adalah $253,5 Hz$.

Saran

Untuk mengetahui kemungkinan adanya perilaku lapisan sebagai *band rejection filter* maka pengamatan $G(\omega)$ perlu dilanjutkan pada frekuensi yang lebih besar

dari 1 MHz. Demikian pula untuk menentukan besar $G(\omega)$ untuk sampel hasil deposisi pada $B_{dep} = 450$ G, perlu dilakukan pengamatan $G(\omega)$ pada frekuensi yang lebih kecil dari 100 kHz.

DAFTARACUAN

- [1]. OPPENHEIM, A.V., and SCHAFER, R.W. *Discrete-time signal processing*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, (1989)
- [2]. HARYADI, B., *Perancangan Sistem Deteksi Irama Jantung Berbasis Komputer Mikro*, Skripsi S-1, FMIPA UAD, Yogyakarta, (2002)
- [3]. LESURF, J. jcgl@st-and.ac.uk, University of St. Andrews, Fife KY 16 9SS, Scotland, (2004)
- [4]. SUTRISNO, *Elektronika Teori Dasar dan Penerapannya*, Penerbit ITB, Bandung, (1986)
- [5]. HOLKO. R., *Introduction to Metal Detector Filters*, ...*Lesurf, J. 2004, jcgl@st-and.ac.uk, University of St. Andrews, St Andrews, Fife KY16 9SS, Scotland, (2005)*
- [6]. Wolfe, J., <http://www.phys.unsw.edu.au/~jw/RCfilters.html>

TANYA JAWAB

Achmad Hindasyah, (P3IB - BATAN)

Pertanyaan

1. Kenapa sinyal keluaran pada 300 Gaus di osciloscop lebih kecil dari sinar masukan. Apakah terjadi pembebanan.
2. Bagaimana cara melihat $t = RC$ dari grafik yang ditampilkan .

Jawaban

1. Sinyal keluaran untuk sampel pada $B_{dep} = 300$ G lebih kecil dari dari sinyal masukan menunjukkan bahwa untuk mencapai keadaan jenuh muatan listrik diperlukan waktu yang lebih lama. Penyebabnya adalah besarnya beban (tahanan) pada lapisan tersebut yaitu :

$$X_c = \frac{BR}{W} = 105,83 \text{ M}\Omega$$

2. Cara melihat $t = RC$ dari grafik adalah dengan *menfitting* data (t_p, V_i) menurut persamaan $Y = Y_0 + Ae^{-Bx}$ dengan $Y = V$ dan $x = t$. Persamaan tersebut sama dengan bentuk tegangan keluran pada kapasitor :

$$V(t) = V_{max} (1 - e^{-t/RC})$$

Pada $t=RC$ persamaan menjadi :

$V(t) = V_{max} (1 - 1/e) = 0,66 V_{max}$ maka t yang bersesuaian dengan nilai ini adalah RC . Dengan diketahui nilai $R = R_0 + R_L$ (R luar + R lapisan) maka C dapat ditentukan.